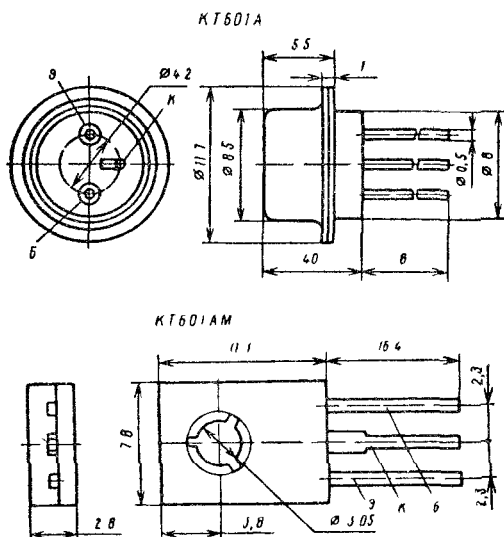


КТ601А, КТ601АМ

Транзисторы кремниевые диффузионные структуры при усилительные. Предназначены для применения в радиовещательных и телевизионных приемниках. Выпускаются в металлостеклянном (КТ601А) и в пластмассовом (КТ601АМ) корпусах с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса КТ601А не более 2 г, КТ601АМ — не более 0,7 г.



Электрические параметры

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{KB}=20$ В, $I_B=20$ мА, не менее		16
$T=25 \text{ } ^\circ\text{C}$		10
$T=-40 \text{ } ^\circ\text{C}$		40 МГц
Граничная частота при $U_{KB}=20$ В, $I_B=10$ мА, не менее		15 пс
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{KB}=50$ В, $I_B=6$ мА, $f=2$ МГц, не более		15 пФ
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB}=20$ В не более		300 мкА
Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{KB}=100$ В, $R_{об}=10$ кОм, не более		100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ0}=2$ В, не более		

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база	100 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{об}=10$ кОм	100 В
Постоянное напряжение эмиттер — база	2 В
Постоянный ток коллектора	30 мА
Постоянный ток базы	30 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
без теплоотвода, $T \approx +55 \text{ } ^\circ\text{C}$ и $T_K = +75 \text{ } ^\circ\text{C}$	250 мВт
с теплоотводом, $T_K = +55 \text{ } ^\circ\text{C}$	500 мВт
Температура p-n перехода	+150 $^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	-40...+85 $^\circ\text{C}$

Изгиб выводов транзисторов КТ601А допускается не ближе 5 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 3 мм. При этом необходимо обеспечить неподвижность вывода между местом изгиба и стеклянным изолятором.

Изгиб выводов транзисторов КТ601АМ допускается под углом не более 90° в плоскости, перпендикулярной плоскости основания корпуса, и не ближе 3 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм.

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса в течение не более 5 с. Температура пайки не должна превышать +260 $^\circ\text{C}$. При этом необходимо обеспечить надежный теплоотвод между корпусом транзистора и местом пайки.

